

SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

FZT696B

ISSUE 4 – FEBRUARY 1997

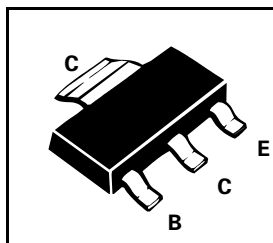
FEATURES

- * 250 Volt V_{CE0}
- * Gain of 500 at $I_C=100\text{mA}$
- * Very low saturation voltage

APPLICATIONS

- * Darlington replacement
- * Battery powered circuits

PARTMARKING DETAIL – FZT696B



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	180	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	180	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	1	A
Continuous Collector Current	I_C	0.5	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$)

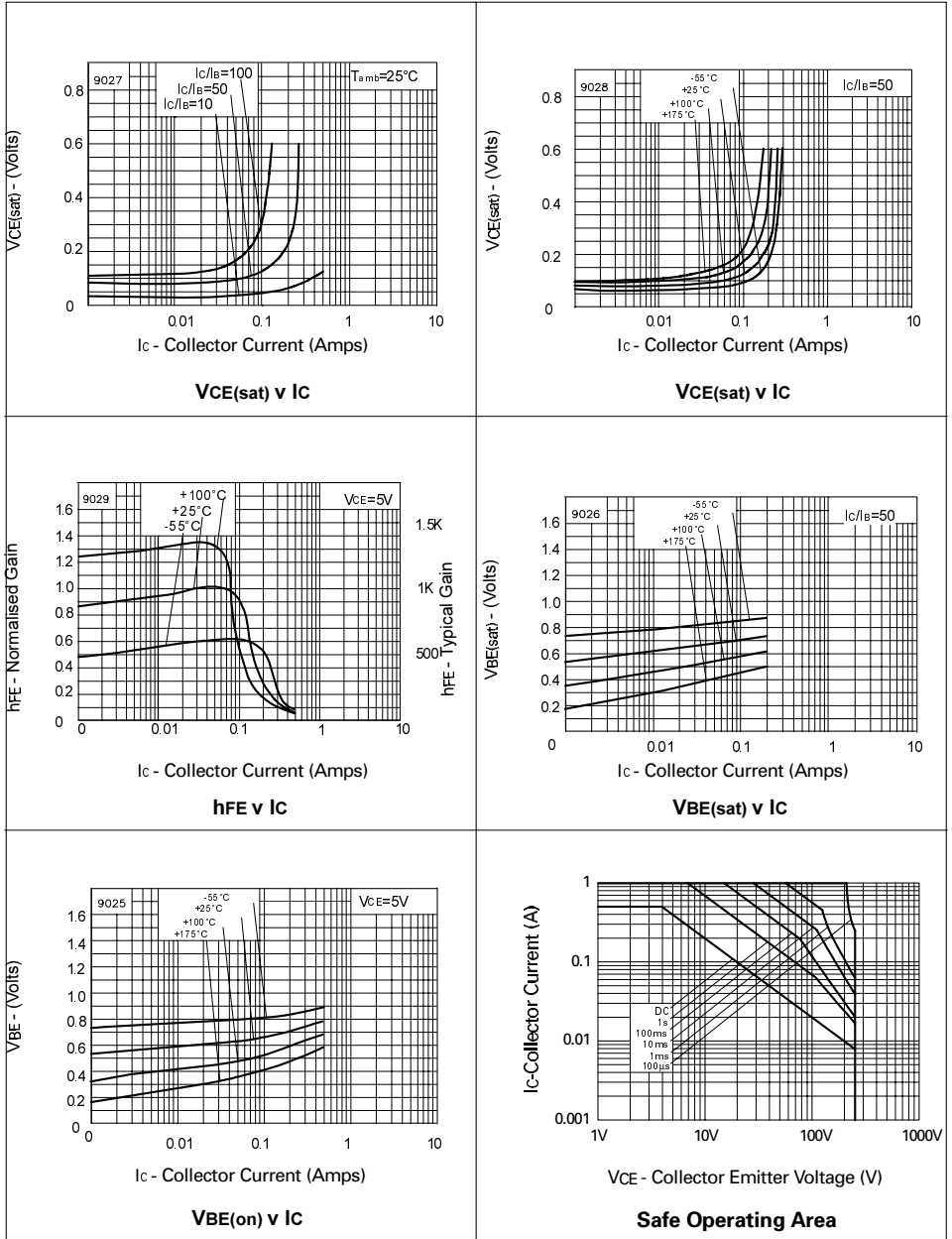
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	180			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	180			V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			0.1	μA	$V_{CB}=140\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			0.1	μA	$V_{EB}=4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.2 0.2 0.25	V	$I_C=50\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}^*$ $I_C=100\text{mA}, I_B=2\text{mA}^*$ $I_C=200\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			0.9	V	$I_C=200\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			0.9	V	$I_C=200\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	500 150				$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=200\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	70			MHz	$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Input Capacitance	C_{ibo}		200		pF	$V_{EB}=0.5\text{V}, f=1\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		6		pF	$V_{CE}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on} t_{off}		80 4400		ns ns	$I_C=100\text{mA}, I_{B1}=10\text{mA}$ $I_{B2}=10\text{mA}, V_{CC}=50\text{V}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for this device

FZT696B

TYPICAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9